

Teledyne e2v HiRel ajoute deux HEMT GaN haute puissance à sa gamme de 650 V

[Teledyne e2v HiRel](#) ajoute deux nouveaux HEMT (transistors à haute mobilité électronique) de puissance GaN renforcés à sa [gamme de produits haute puissance](#) de 650 volts à la pointe du secteur basée sur la technologie GaN Systems.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : <https://www.businesswire.com/news/home/20210106005956/fr/>

Teledyne HiRel's two new GaN HEMTs added to its 650 V Family. (Photo: Business Wire)



Les deux nouveaux HEMT haute puissance, [TDG650E30B](#) et [TDG650E15B](#), offrent des performances à plus faible courant de 30 et 15 ampères respectivement, tandis que le 650 V original introduit l'année dernière, le [TDG650E60](#), délivre 60 A.

Ces HEMT GaN 650 V sont les dispositifs d'alimentation GaN à tension la plus élevée disponibles sur le marché pour les applications militaires, avioniques et spatiales exigeantes à haute fiabilité. Ils conviennent parfaitement aux applications telles que l'alimentation électrique, la commande de moteur et les topologies en demi-pont.

Ils sont livrés avec une configuration refroidie par le bas et sont dotés d'une matrice à FOM Island Technology® ultra-faible, d'un boîtier GaNPX® à faible inductance, d'une commutation à très haute fréquence de >100 MHz, de délais de chute et de montée rapides et contrôlables, d'une capacité de courant inverse, et bien plus.

« Nous sommes ravis de poursuivre le développement de notre gamme de HEMT GaN haute puissance 650 V destinée aux applications nécessitant la plus grande fiabilité dont l'espace », a

déclaré Mont Taylor, vice-président du développement commercial chez Teledyne e2v HiRel. « Nous pensons qu'avec leur boîtiers plus compacts, ces nouveaux dispositifs conviendront vraiment aux clients qui conçoivent des projets à densité de puissance la plus élevée. »

Le TDG650E15B et le TDG650E30B sont tous deux des transistors de puissance GaN-sur-silicium en mode d'optimisation qui permettent un courant élevé, une panne haute tension et une fréquence de commutation élevée tout en offrant une très faible résistance thermique jonction-boîtier pour les applications haute puissance.

Les dispositifs au nitrure de gallium ont révolutionné la conversion de puissance dans d'autres industries et sont maintenant disponibles dans des boîtiers encapsulés en plastique tolérants aux rayonnements qui ont subi des tests de fiabilité et électriques rigoureux pour assurer le succès critique de la mission. Le lancement de ces nouveaux HEMT GaN offre aux clients les avantages requis par les applications électriques essentielles des secteurs de l'aérospatiale et de la défense en matière d'efficacité, de taille et de densité de puissance.

Pour toutes les gammes de produits, Teledyne e2v HiRel effectue la qualification et les tests les plus exigeants adaptés aux applications à fiabilité maximale. Pour les appareils électriques, ce régime comprend un test sulfurique, une simulation à haute altitude, un rodage dynamique, une contrainte par palier allant jusqu'à 175 ° C ambiant, une tension de grille de 9 volts et des tests de température exhaustifs. Contrairement aux dispositifs au silicium sur carbure (SiC), ces deux dispositifs peuvent facilement être configurés en parallèle pour augmenter le courant de charge ou abaisser le RDSon effectif.

Ces deux nouveaux dispositifs sont dès à présent disponibles à la commande et à l'achat immédiat.

À propos de Teledyne e2v HiRel

Les innovations de Teledyne e2v HiRel permettent des développements dans les marchés de l'espace, des transports, de la défense et de l'industrie. L'approche unique de Teledyne e2v HiRel consiste à analyser les défis du marché et des applications des clients pour ensuite, en collaboration avec ces derniers, fournir des solutions innovantes standard, semi-personnalisées ou entièrement personnalisées, apportant une valeur accrue à leurs systèmes. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.teledynedefelec.com

À propos des GaN Systems

Leader mondial des semi-conducteurs de puissance GaN, GaN Systems offre le plus vaste portefeuille de transistors répondant parfaitement aux besoins des industries les plus exigeantes d'aujourd'hui, notamment les serveurs de centres de données, les systèmes d'énergie renouvelable, l'automobile, les moteurs industriels et l'électronique grand public. En tant qu'innovateur leader sur le marché, GaN Systems permet de concevoir des systèmes électriques plus compacts, plus économiques et plus efficaces. Les produits primés de la société permettent de concevoir des systèmes libres des limitations du silicium d'hier. En modifiant les critères de performance des transistors, GaN Systems permet aux entreprises spécialisées en conversion de puissance de révolutionner leurs industries et de transformer le monde. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.gansystems.com ou suivez GaN Systems sur Facebook, Twitter et LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.



Consultez la version source sur businesswire.com :
<https://www.businesswire.com/news/home/20210106005956/fr/>